

SOT-23



Pin Definition:

1. Gate
2. Source
3. Drain

Key Parameter Performance

| Parameter | Value | Unit |
|--------------------|------------------|------|
| V_{DS} | -20 | V |
| $R_{DS(on)}$ (max) | $V_{GS} = -4.5V$ | 50 |
| | $V_{GS} = -2.5V$ | 65 |
| | $V_{GS} = -1.8V$ | 85 |
| Q_g | 9.6 | nC |

Features

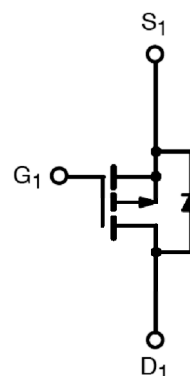
- Fast Switching
- Suited for -1.8V Gate Drive Applications
- Halogen-free

Ordering Information

| Part No. | Package | Packing |
|-----------------|---------|----------------|
| TSM500P02CX RFG | SOT-23 | 3Kpcs / 7+Reel |

Note: %G+denotes for Halogen- and Antimony-free as those which contain <900ppm bromine, <900ppm chlorine (<1500ppm total Br + Cl) and <1000ppm antimony compounds

Block Diagram



P-Channel MOSFET

Absolute Maximum Ratings ($T_C = 25^\circ C$ unless otherwise noted)

| Parameter | Symbol | Limit | Unit |
|------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|
| Drain-Source Voltage | V_{DS} | -20 | V |
| Gate-Source Voltage | V_{GS} | ± 10 | V |
| Continuous Drain Current | I_D | $T_C = 25^\circ C$ | -4.7 |
| | | $T_C = 100^\circ C$ | -3 |
| Pulsed Drain Current ^(Note 1) | I_{DM} | -18.8 | A |
| Power Dissipation @ $T_C = 25^\circ C$ | P_D | 1.56 | W |
| Operating Junction Temperature | T_J | 150 | $^\circ C$ |
| Storage Temperature Range | T_{STG} | -55 to +150 | $^\circ C$ |

Thermal Performance

| Parameter | Symbol | Limit | Unit |
|------------------------------------------|----------|-------|--------------|
| Thermal Resistance - Junction to Ambient | R_{JA} | 80 | $^\circ C/W$ |

Electrical Specifications ($T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

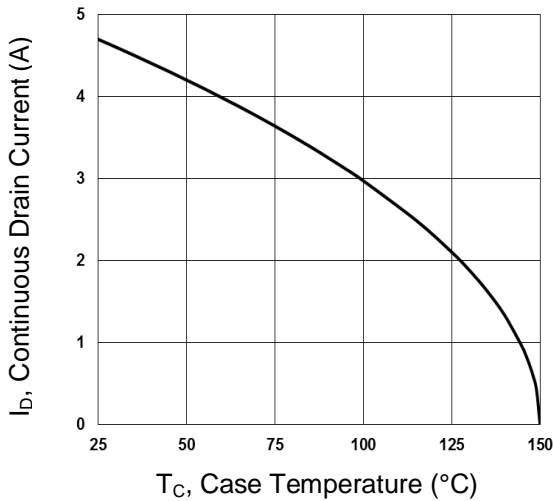
| Parameter | Conditions | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------|---------|
| Static | | | | | | |
| Drain-Source Breakdown Voltage | $V_{GS} = 0V, I_D = -250\mu A$ | BV_{DSS} | -20 | -- | -- | V |
| Drain-Source On-State Resistance | $V_{GS} = -4.5V, I_D = -3A$ | $R_{DS(ON)}$ | -- | 42 | 50 | m |
| | $V_{GS} = -2.5V, I_D = -2A$ | | -- | 57 | 65 | |
| | $V_{GS} = -1.8V, I_D = -1A$ | | -- | 75 | 85 | |
| Gate Threshold Voltage | $V_{DS} = V_{GS}, I_D = -250\mu A$ | $V_{GS(TH)}$ | -0.3 | -0.6 | -0.8 | V |
| Zero Gate Voltage Drain Current | $V_{DS} = -20V, V_{GS} = 0V$ | I_{DSS} | -- | -- | -1 | μA |
| | $V_{DS} = -16V, T_J = 125^\circ\text{C}$ | | -- | -- | -10 | |
| Gate Body Leakage | $V_{GS} = \pm 10V, V_{DS} = 0V$ | I_{GSS} | -- | -- | ± 100 | nA |
| Forward Transconductance ^(Note 2) | $V_{DS} = -10V, I_D = -3A$ | g_{fs} | -- | 7 | -- | S |
| Dynamic | | | | | | |
| Total Gate Charge ^(Note 2,3) | $V_{DS} = -10V, I_D = -3A,$ $V_{GS} = -4.5V$ | Q_g | -- | 9.6 | -- | nC |
| Gate-Source Charge ^(Note 2,3) | | Q_{gs} | -- | 1.6 | -- | |
| Gate-Drain Charge ^(Note 2,3) | | Q_{gd} | -- | 2 | -- | |
| Input Capacitance | $V_{DS} = -10V, V_{GS} = 0V,$ $f = 1.0\text{MHz}$ | C_{iss} | -- | 850 | -- | pF |
| Output Capacitance | | C_{oss} | -- | 70 | -- | |
| Reverse Transfer Capacitance | | C_{rss} | -- | 55 | -- | |
| Switching | | | | | | |
| Turn-On Delay Time ^(Note 2,3) | $V_{DD} = -10V, I_D = -1A,$ $V_{GS} = -4.5V, R_{GEN} = 25$ | $t_{d(on)}$ | -- | 6 | -- | ns |
| Turn-On Rise Time ^(Note 2,3) | | t_r | -- | 21.6 | -- | |
| Turn-Off Delay Time ^(Note 2,3) | | $t_{d(off)}$ | -- | 51 | -- | |
| Turn-Off Fall Time ^(Note 2,3) | | t_f | -- | 13.8 | -- | |
| Source-Drain Diode Ratings and Characteristic | | | | | | |
| Maximum Continuous Drain-Source Diode Forward Current | Integral reverse diode in the MOSFET | I_S | -- | -- | -4.7 | A |
| Maximum Pulse Drain-Source Diode Forward Current | | I_{SM} | -- | -- | -18.8 | A |
| Diode-Source Forward Voltage | $V_{GS} = 0V, I_S = -1A$ | V_{SD} | -- | -- | -1 | V |

Note:

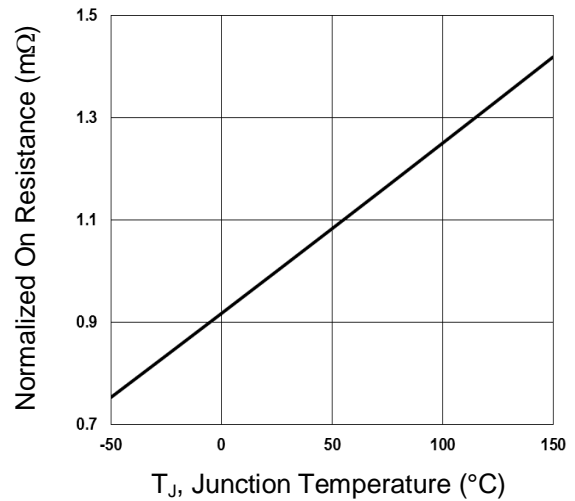
- Pulse width limited by safe operating area
- Pulse test: pulse width $m300\mu s$, duty cycle $m2\%$
- Switching time is essentially independent of operating temperature.

Electrical Characteristics Curves

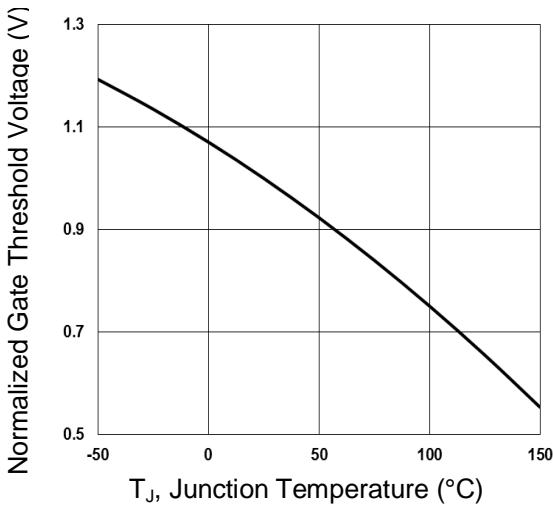
Continuous Drain Current vs. Tc



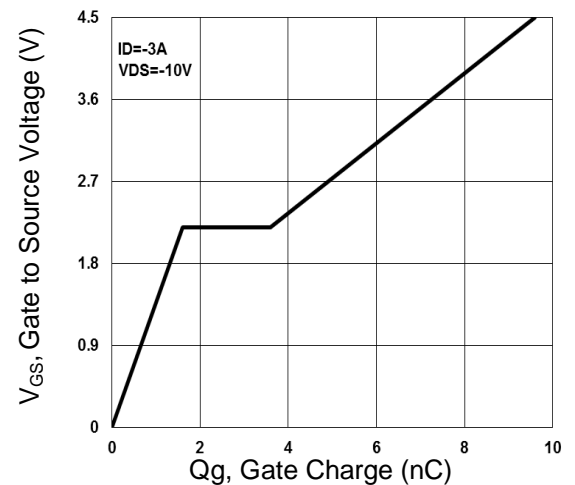
Normalized RDSON vs. T_J



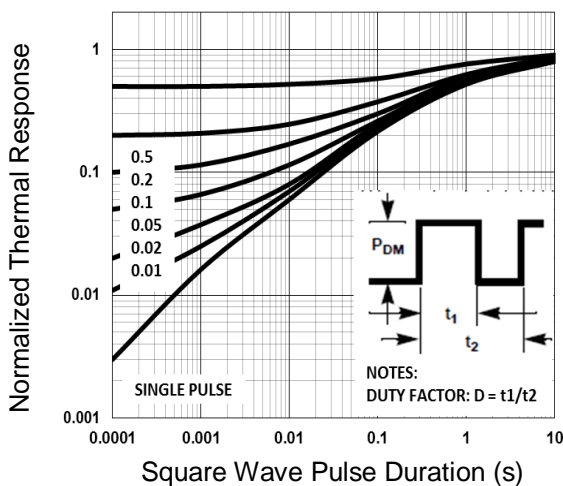
Normalized V_{th} vs. T_J



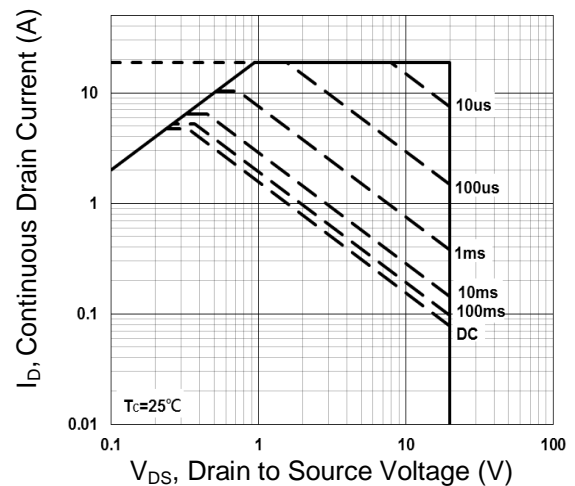
Gate Charge Waveform



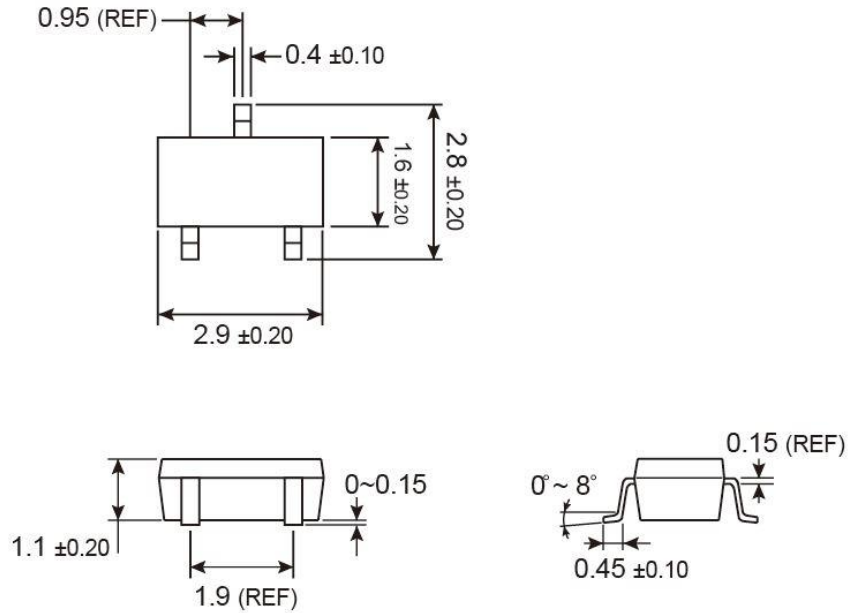
Normalized Transient Impedance



Maximum Safe Operation Area

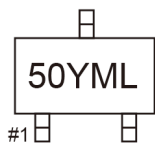


SOT-23 Mechanical Drawing



Unit: Millimeters

Marking Diagram



- 50** = Device Code
- Y** = Year Code
- M** = Month Code for Halogen Free Product
(**O**=Jan, **P**=Feb, **Q**=Mar, **R**=Apr, **S**=May, **T**=Jun, **U**=Jul, **V**=Aug, **W**=Sep, **X**=Oct, **Y**=Nov, **Z**=Dec)
- L** = Lot Code

Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. TSC or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in TSC's terms and conditions of sale for such products, TSC assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of TSC products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify TSC for any damages resulting from such improper use or sale.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А